

- 可程式化邏輯元件 (PLD) 386
- 可變電容器 (Varactor) 41, 337, 349
- 可變電容器 (variable reactor) 41, 337, 349
- 失真 (distortion) 290, 340, 450, 456-457
- 平均橫貫電場 (average traverse field) 149
- 平帶狀態 (flat-band condition) 79, 83, 98-100, 109-110, 117
- 平帶電壓 (flat-band voltage) 99-100, 109-116, 281
- 本質半導體 (intrinsic semiconductor) 6-8, 11, 13, 24, 81, 84
- 本質費米能階 (intrinsic Fermi level) 6-7, 11, 13, 24, 33, 77, 81
- 本質載子密度 (intrinsic carrier density) 6
- 本質載子濃度 (intrinsic carrier concentration) 2, 5-6, 8-9, 11, 13
- 本體貫穿 (bulk punch-through) 174
- 未飽和鍵結 (unsaturated bondings) 99
- 未摻雜多晶矽 (undoped Poly-Si) 200
- 正反器 (Flip-Flop) 306-308, 314, 356

六劃

- 交換器 (switch) 397, 399-400, 407, 409
- 光阻 (photoresist, P.R.) 102, 189-192, 196, 200-205, 208, 210-211, 215, 226
- 光阻塗佈 (P.R. coating) 190
- 光罩式唯讀記憶體 (Mask Read Only Memory; Mask ROM) 386
- 全客戶設計 (full custom design) 386
- 全面性應變 (global strain) 265, 268-269
- 共源極 (common source, CS) 323-325, 331
- 共價鍵結 (covalent bonding) 8-9, 11
- 共價鍵結模型 (covalent bonding model) 11
- 再充電 (refresh) 356
- 再補充 (refresh) 366
- 同步 (synchronous) 95, 300, 307, 328-329, 356, 363, 395
- 合成器 (synthesizer) 336, 338
- 回火 (anneal) 104, 106, 108-109, 146, 199, 201, 205, 229, 242
- 多工器 (multiplexer, 簡寫 MUX) 304-305
- 多媒體 (multimedia) 392, 394-396, 398-400, 402-403, 409
- 多晶矽 (poly-Si) 123, 188, 194-196, 200-202, 215, 233, 236-239, 244, 281-283, 334, 356, 363-364, 368, 431-432, 435, 437-441
- 多晶矽空乏 (poly-depletion) 236, 238, 281
- 多晶矽閘極 (poly-Si gate) 188, 195-196, 200, 202, 215, 237